

## Abel García Barrientos



Abel García Barrientos nació en Tenancingo, Tlaxcala, México, en 1979. Recibió la Licenciatura en Electrónica de la Universidad Autónoma de Puebla, México, en 2000, y el M.Sc. y Ph.D. en Electrónica por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), Tonantzintla, Puebla, en 2003 y 2006, respectivamente. Desde 2007 se incorporó como investigador al Departamento de Mecatrónica de la Universidad Politécnica de Pachuca, México. En 2009 fue becario postdoctoral en el Laboratorio de Micro y Nano Sistemas de la Universidad McMaster, Ontario, Canadá. En 2010, el Dr. García-Barrientos fue becario postdoctoral en el grupo de análisis avanzado de materiales y dispositivos del Instituto de Microelectrónica, Technische Universitat Wien, y en el verano de 2013, fue profesor invitado en la Escuela de Física y Astronomía de la Universidad de Nottingham, Reino Unido. Desde 2016, el Dr. García Barrientos es profesor de tiempo completo nivel VI en la facultad de ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sus intereses científicos incluyen simulación de dispositivos, modelado de dispositivos semiconductores, electrónica de alta frecuencia y nanoelectrónica. Es miembro del SNI-México desde 2008 hasta 2022, nivel II. El Dr. García-Barrientos es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias; la subsección IEEE-Hidalgo (México) y es miembro de la Sociedad de Comunicaciones IEEE. El Dr. García-Barrientos es autor y coautor de dos libros, 36 artículos de JCR, 44 artículos de conferencias y libros de 6 capítulos. Ha sido presidente general de la subsección IEEE-Hidalgo desde 2014-2016 y, además, ha sido presidente general de la red temática “Fuentes de Energías Alternas” financiada por PROMEP-SEP-México desde 2013-2015.

Abel García Barrientos was born in Tenancingo, Tlaxcala, Mexico, in 1979. He received the Licenciatura degree in Electronics from the Autonomous University of Puebla, Mexico, in 2000, and the M.Sc. and Ph.D. degree in Electronics from the National Institute for Astrophysics, Optics, and Electronics (INAOE), Tonantzintla, Puebla, in 2003 and 2006, respectively. Since 2007 he joined as a researcher at the Mechatronics Department at the Polytechnic University of Pachuca, Mexico. In 2009 he was a Post-

Doctoral Fellow at the Micro- and Nano-Systems Laboratory at the McMaster University, Ontario, Canada. In 2010 Dr. Garcia-Barrientos was a Post-Doctoral Fellow at the Advanced Materials and Device Analysis group of Institute for Microelectronics, Technische Universitat Wien, and in the summer 2013, he was a visiting professor at the Physics and Astronomy School at The University of Nottingham, UK. Since 2016, Dr. Garcia Barrientos is a full-time professor level VI at the faculty of science at the Universidad Autonoma de San Luis Potosi. His scientific interests include device simulation, semiconductor device modeling, high-frequency electronics, and nanoelectronics. He has been member of SNI-Mexico since 2008 until 2022, level II. Dr. Garcia-Barrientos is a Fellow of the Mexican Academy of Science; the IEEE- Hidalgo subsection (Mexico) and he is member of the IEEE Communications Society.

Dr. Garcia-Barrientos is author and co-author of two books, 36 JCR Journal papers, 44 conferences papers and 6 chapters' books. He has been general chair of the IEEE-Hidalgo subsection from 2014-2016 and, also, He has been general chair of the network thematic "Fuentes de Energias Alternas" financed by PROMEP-SEP-Mexico from 2013-2015.